

(19)
(12)(KR)
(A)(51) 。 Int. Cl. ⁷
H05B 33/10(11)
(43)2002 - 0040998
2002 05 31(21) 10 - 2000 - 0070712
(22) 2000 11 25

(71)

1355 - 26

1 951 - 20 26/3 3 - 101

(72)

219 - 27

1 951 - 20 26/3 3 - 101

(74)

:

(54)

(Full Color)

EL

	(3),	2	(4),	3	(1)	(2)	;	(2)
1	(3),	2	(4),	3	(5)		;	1 (3)
	,	2	(4)			(6a)	,	3 (5)
2	(4)	(6a)		(6)		;	2 (4)	(6a) (7a)
		;	(7a)		(8a)		;	(8a) (9)
	;	3	(5)		(7b),		;	(8b) (9)

, , , , ,

1 EL ,

2 10 .

< >

1 : 2 : (ITO) ,

3 : 1 , 4 : 2 ,

5 : 3 , 7 : ,

8 : 9 :

22 : (Red) , 23 : (Green) ,

24 : (Blue) .

(Electro - Luminesecence, " EL")
(Full Color)

EL

EL .

EL PDA , ,
가 .

1 (Passive Matrix) 가 EL .
EL , 1 (10)
ITO(Indium Tin Oxide) () (20) . (20) / /
(30) (30) () (40)
EL SUS () ,
가 가 .

가 , EL (40) " - " 가 , ITO (20) " + "
가 , (40)
20) (10) (30) . ITO (

EL (Organic Material)
R.G.B. 가 가

가 1 가

(1) (2) ; (2)
1 (3), 2 (4), 3 (5) ; 1 (3)
(4) 2 (4) (6a) (5)
2 (4) (6a) (6) ; 2 (4) (6a) (7
a) ; (7a) (8a) ; (8a) (9)
; 3 (5) (7b), (8b) (9)

1 (3), 2 (4) 3 (5) SiO₂, SiNx

3 (5) 1 (3) 2 (4)

CMP (Chemical Mechanical Polishing)

(Dry Etching)

가

(22) ;
(22) (23) ;
(23) (24) ;

(1); (1) (2);
(2) 1 (3); 1 (3)
(6a) 2 (4); 2 (4) (4) (
(6) 3 (5); 1 (3) 2 (4) (
6a) 2 (4) (7a); (7a)
(8a); (8a) 3 (5)
(9);

(22);
(22) (23);
(23) (24);

2 10
2 10

2 (1)

3 (1) ITO () (2)

4 (2) 1 (3), 2 (4) 3 (5)

SiO₂, SiNx 1

(3), 2 (4) 3 (5) (2)

(Strip) (3) 2 (4) (2) , 3 (5) 1

5 (6a) 1 (3) , 2 (4) (6)

6 (6a) (Blue) (7a) (7a) 2 (4)

2 (4) 3 (5) (7a) 1 (3) ,

(7b) 3 (5)

7 (7b) (7a) (7b) (8a, 8b)

(8b) (8a, 8b)

8 (8a, 8b) (9) (9)

3 (5) (6) 가 (9)

9 (9) 3 (5)

CMP (Chemical Mechanical Polishing) (Dry Etching)

가 가 ()

10 (3, 4, 5)

(, 1 , 1) , R.G.B.

10 (Red) (22), (G

reen) (23), (Blue) (24)가

가

EL

가

가

(Anode)

(Cathode)

가

가

가

(57)

1.

(1)

(2)

;

(2)

1

(3),

2

(4),

3

(5)

;

1

(3)

,

2

(4)

(6a)

,

3

(5)

2

(4)

(6a)

(6)

;

2

(4)

(6a)

(7a)

;

(7a)

(8a)

;

(8a)

(9)

;

3

(5)

(7b),

(8b)

(9)

2.

1

,

1

(3),

2

(4)

3

(5)

SiO₂, SiNx

3.

1

,

3

(5)

1

(3)

2

(4)

4.

1

,

CMP(Chemical Mechanical Polishing)

5.

1 3 (22) ;

1 3 (22) (23) ;

1 3 (23) (24) ;

6.

(1);

(1) (2);

(2) , 1 (3);

1 (3) , (6a) 2 (4);

2 (4) , 2 (4) (6a) (6) 3 (5);

1 (3) 2 (4) (6a) , 2 (4)
(7a);

(7a) (8a);

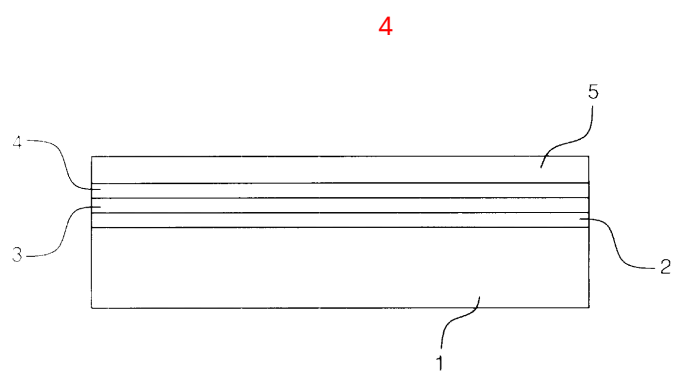
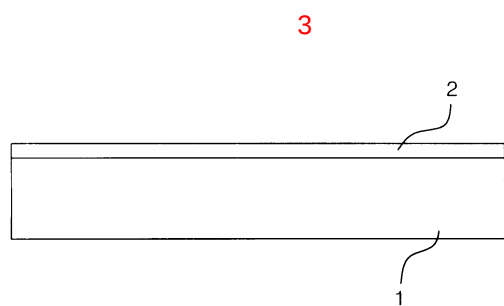
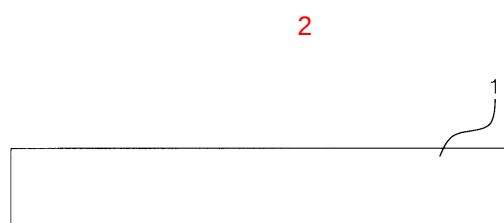
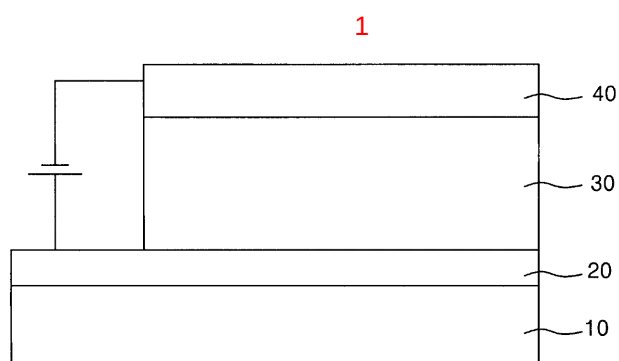
(8a) , 3 (5) (9);

7.

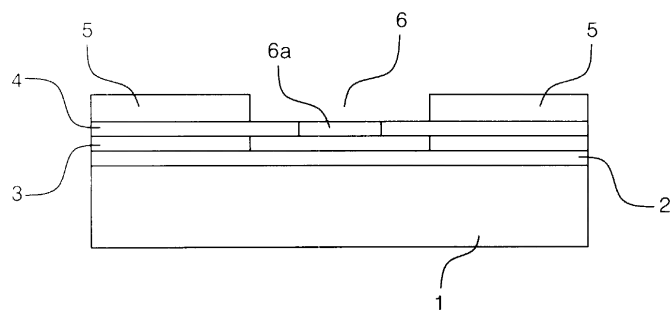
6 (22);

6 , (22) (23);

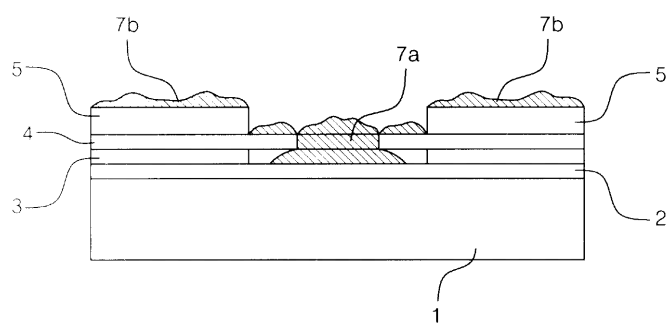
6 , (23) (24);



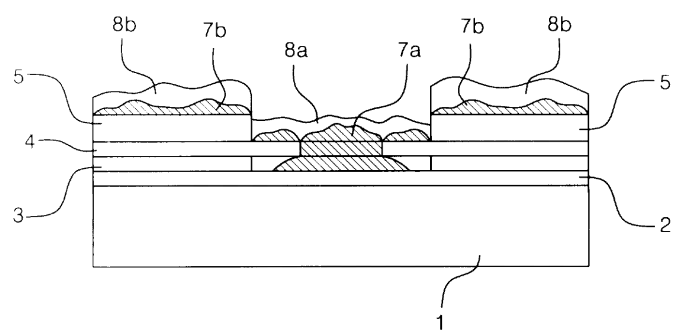
5



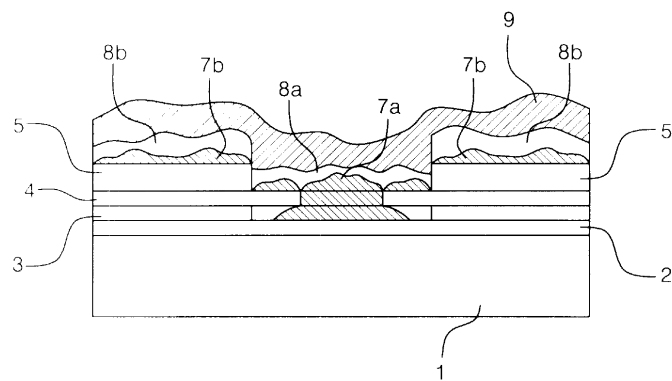
6



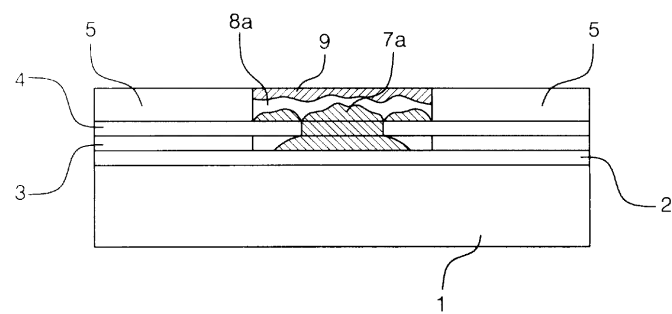
7



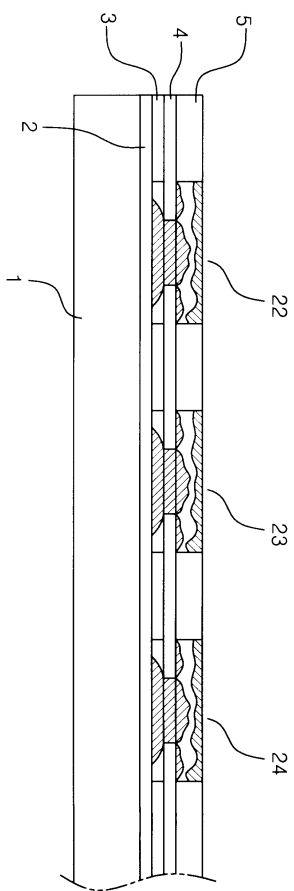
8



9



10



专利名称(译)	有机电致发光显示面板及其制造方法		
公开(公告)号	KR1020020040998A	公开(公告)日	2002-05-31
申请号	KR1020000070712	申请日	2000-11-25
[标]申请(专利权)人(译)	ELIATECH 公园胜利 Bakwonseok		
申请(专利权)人(译)	电梯技术有限公司. Bakwonseok		
当前申请(专利权)人(译)	电梯技术有限公司. Bakwonseok		
[标]发明人	KANG SINKYU 강신규 PARK WON SEOCK 박원석		
发明人	강신규 박원석		
IPC分类号	H05B33/10		
CPC分类号	H01L27/3211 H01L51/56		
代理人(译)	孙某EUN JIN		
其他公开文献	KR100358503B1		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明涉及用于提高全色（全色）微图案对准精度的有机电子发光显示板及其制造方法。为此，提供了在透明基板（1）上沿特定方向沉积阳极层（2）的步骤：形成宽度大于第二绝缘的凹槽（6a）的凹槽（6）的步骤在所述第三绝缘层（5）的上侧的层（4）中，在连续形成第一绝缘层的步骤中，在第二绝缘层（4）上形成窄沟槽（6a）的凹槽（6a）。

（3）在阳极层（2）的上侧，第二绝缘层（4）和第三绝缘层（5）：固定宽度的第一绝缘层（3）：形成沟槽（6a）的第二绝缘层（4）的内部部分的发光层（7a）的步骤：形成步骤发光层（7a）上侧的阴极层（8a）：在阴极层（8a）的上侧形成保护层（9）的步骤：发光材料残留物（7b）放置在第三绝缘层（5）上侧的有机电致发光显示板的制造方法包括去除阴极材料残留物（8b）和保护层（9）并平坦化的步骤和面板。有机，电致发光，面板，沉积，绝缘体，金属。

